Vol 25

2004年12月

高等学校化学学报 CHEM ICAL JOURNAL OF CHNESE UN MERSITIES No. 12 2322~ 2326

聚苯胺对纳米 CdS 的光致发光增强效应

席燕燕¹,周剑章¹,张 彦¹,董 平¹,

蔡成东¹, 黄怀国^{2,3}, 林仲华¹

(1. 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室,化学系,物理化学研究所,厦门 361005;

2 厦门紫金科技股份有限公司, 厦门 361000;

3 福建紫金矿冶研究院,福建紫金矿业股份有限公司,龙岩 364200)

 摘要
 利用电化学脉冲沉积法在聚苯胺(PAN I) 膜上制备了纳米 CdS/PAN I 复合膜,并利用扫描电镜光谱、

 紫外可见光谱、红外光谱、拉曼和荧光等光谱技术表征复合膜的形貌、结构及性质、CdS/PAN I 复合膜中

 CdS 微粒呈现量子尺寸效应;
 CdS 和 PAN I 间存在相互作用;由于聚苯胺和 CdS 能级的合适匹配,聚苯胺对

 CdS 的光致发光(PL)有增强效应,增强机理为光生载流子的传递机理

 关键词
 纳米硫化镉;聚苯胺;复合膜;光致发光

 中图分类号
 O 646

文章编号 0251-0790(2004) 12-2322-05

聚苯胺类导电聚合物易合成、价格低廉、稳定性好,而且具有许多优良的光电化学性能,是最有希望在实际中得到应用的聚合物电子材料之一^[1,2]. CdS 是典型的 II - VI族半导体,纳米 CdS 微粒膜既有异于体相材料,又不同于单个纳米微粒的特殊性质 量子尺寸效应使 CdS 能级改变和能隙变宽,吸收和发射光谱向短波方向移动,直观上表现为颜色由黄变为浅黄 表面效应引起 CdS 纳米微粒膜表面原子输运和构型的变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化,这对于其光学、电学及非线性光学性质等具有重要影响 因而纳米 CdS 微粒膜的制备和表征日益引起人们的重视^[3~ 6].

纳米 CdS 与 PAN I 相结合, PAN I 可起到载体作用,不仅可以防止纳米微粒聚结,而且可以控制 粒子的尺寸和分布,提高稳定性,并表现出不同于单一 CdS 纳米微粒膜的性质 本文采用电化学方法 制备纳米 CdS / PAN I 复合膜,利用光谱技术表征其结构及 CdS 与 PAN I 间的相互作用,发现聚苯胺对 CdS 的光致发光有增强效应

1 实验部分

1.1 试剂 材料和仪器

对氨基苯硫酚(PATP)购于 Sigm a 公司, 苯胺溶液用A. R. 级苯胺经减压蒸馏后的无色透明的纯液体配制, CdCb, HCD4, 二甲亚砜和乙醇均为分析纯试剂, 单质S 为化学纯, 淋洗所用水均为三次蒸馏水

Au 片基底为新剥离的云母片上磁控溅射的金膜, PATP / Au 膜经清洗过的 Au 膜在 10 mmol/ L 的 PATP 的乙醇溶液中浸泡 12 h 制得

德国LEO 公司生产的LEO 1530 场发射扫描电子显微镜(SEM);美国Varian 公司生产的Cary 5000 紫外-可见分光光度计. CdS/ITO 的吸收光谱采用透射的方法测定,其它膜均采用漫反射方法测定,法国DLOR 公司生产的LABRAM [型共焦显微Raman 光谱仪; Hitachi 公司生产的F-4500 型荧光光谱仪;英国VG 公司生产的 ESCALABM K-II型X 射线光电子能谱仪;美国Nicolet 公司生产的 740 红外光谱仪,MCT-B 检测器;电化学实验采用 EG-GPAR 173 恒电位仪和 CH F-660 型综合测试仪; 光电化学实验采用自行设计的测量系统进行.

7

收稿日期: 2003-10-09.

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 29833060, 20173044)和福建省青年科技人才创新基金(批准号: 2001/031)资助 联系人简介: 林仲华(1941年出生),男,教授,博士生导师,从事电化学研究 E-maik Zhlin@xmu edu cn

1.2 膜的制备

PAN I 膜的制备: 以 PA TP /A u 膜为基体,在 0.5 mol/L 苯胺-HC D₄ 溶液中,利用循环伏安法,于 电 位- 0.2~+0.7 V (本文中所示电位除另行说明外,均相对于饱和甘汞电极),电位扫描速度 100 m V /s,扫描 100 循环,扫描后恒定电位在 0.4 V,以使 PAN I 呈部分氧化态(导电态).制成的膜以 PAN I/PA TP /A u 表示

纳米 CdS 膜的制备:在 B aran sk i 等^[7,8]的工作基础上,采用电流脉冲法制备 CdS 微粒膜(脉冲幅度为 1 mA / cm²,脉冲宽度 Δt = 2 s,脉冲数 n= 30).电解槽采用两电极系统,分别以 PAN I/PA TP /A u 或导电玻璃(ITO)和 A u 为工作电极,铂片为辅助电极 电解液为 0.055 mol/L 氯化镉和 0.19 mol/L 单 质硫的二甲亚砜 (DM SO)溶液 沉积温度控制在 100 .电沉积得到浅黄色的 CdS 微粒膜用热的 DM SO 清洗,再用高纯氮气吹干后备用 制成的膜分别以 CdS / PAN I/PA TP /A u, CdS / ITO 和 CdS /A u 表示 用于制备纳米 CdS 膜的电极的表观面积相等,电沉积的总电量也相等

2 结果与讨论

2.1 复合膜的表征

图 1 为 PAN I/PA TP/A u 膜和 CdS/PAN I/PA TP/A u 复合膜的扫描电镜图 由图 1 可看出,在纤维状的 PAN I 膜上, CdS 微粒形成大约 20~30 nm 的岛状物,在放大到 10 万倍的扫描电子显微镜下仍 无法分辨出具体的每个颗粒,不过 SEM 观察到的实际上是由 CdS 纳米微粒堆积成的聚集体,以下光 谱实验出现的量子尺寸效应将证明这一点





块体 CdS 的禁带宽度为 2.42 eV,因此,其吸收光谱中主吸收带启动 (on set) 波长为 515 nm,当 CdS 的颗粒尺寸小于 8 nm 时出现量子尺寸效应^[9],表现在吸收光谱上主吸收带吸收边蓝移,并可能出 现分立的谱带.图 2(A)为用透射方法测定的 ITO 上 CdS 微粒膜的吸收光谱,从谱图可以看出,主吸 收边在 500 nm 附近,相对于块体蓝移了 15 nm.根据 Brus 等^[10,11]提出的公式:

$$E_{g}(R) = E_{g} + \frac{h^{2}}{8R^{2}}(m_{e}^{-1} + m_{h}^{-1}) - \frac{1.8e^{2}}{4\pi\epsilon_{0}\epsilon_{R}}$$

式中 $E_{g}(R = 0)$ 为块体材料的禁带宽度, m_{e} 和 m_{h} 分别为电子和空穴的有效质量, ϵ 为块体材料的介电 常数, R为半导体纳米颗粒的半径 估算得到粒子尺寸约为 7~8 nm. 从 350 nm 处至短波出现 1 个分 立谱带.



图 2(B)为由反射法测定的吸收光谱,比较图中的 2 条谱线可看出,相对于 PAN I 膜, CdS/PAN I 复合膜的吸收光谱从 500 nm 开始有一新的吸收带,并且该谱带在 250 nm 附近出现 1 个分立谱带,因 为用漫反射方法得到吸收光谱时难以准确校正基底的影响,所以CdS/PAN I 复合膜的吸收谱带有强的 吸收背景 可见复合膜上的 CdS 微粒与 IFO 上的 CdS 微粒具有相似的谱带,因此二者 CdS 微粒的尺

寸相近 同时由于 CdS 与 PAN I的相互作用, 归属 于 PAN I苯环和醌环的 π-π^{*} 电子跃迁谱带(700 nm 附近)发生了蓝移, 归属于由苯环 π和 π^{*} 轨道组成 的价带和导带间跃迁的谱带(400 nm 附近)减弱 由此可见, 虽然在扫描电镜图(图 1)上, 只看到 PAN I上岛状分布的 CdS 纳米微粒聚集体, 但这些 聚集体由约 7~ 8 nm 的纳米微粒构成, 在电子吸收 光谱上依然表现出纳米微粒而不是它的聚集体的光 吸收性质

为了进一步证实CdS/PAN I 复合膜中, CdS 与





PAN I之间的相互作用,分别测定了 PAN I/PA TP/A u 和 CdS/PAN I/PA TP/A u 的红外漫反射谱图(图 3),与 PAN I相比,复合膜中苯环的一些特征峰¹¹²¹相同,但位于 1 306 cm⁻¹的强 C—N 伸缩振动的谱 带有较大的红移,同时,归属于N—H 振动的 3 306 和 3 384 cm⁻¹处的谱带有大的增强,这可能是 CdS 与 PAN I的—NH 相互作用的结果 同时,还测定了 CdS/PAN I/PA TP/A u 复合膜的 Cd₃₄ [图 4(A)]和 S₂,[图 4(B)]的 XPS 区域能谱图 在 405.1 和 412.0 eV 附近出现了 Cd 的 $3d_{5/2}$ 和 $3d_{3/2}$ 电子结合能谱 峰;在 163.8 eV 处出现了 S₂,的电子结合能谱峰 此谱峰位置位于 CdS 和单质 S 的 S₂,结合能之间(分 别为 161.7 和 164.1 eV),表明可能由于 PAN I中的自由基阳离子部分地氧化了 CdS 中的二价 S,同时 还可能包含了 PA TP 中 S 的贡献



Fig 4 XPS spectra of Cd₃₄(A) and S2_p(B) region in CdS/PANI/PATP/Au composite f ilm 图 5 为CdS/PAN I/PA TP/Au 复合膜的拉曼光谱 在 308 cm⁻¹附近有 1 个拉曼谱峰,归属于CdS 一级光学声子纵波(LO)的泛音拉曼谱^[13],它可能是CdS 中的激子产生点阵畸变而产生的^[14]谱 另外,







Fig. 6 Photoluminescence spectra of CdS/PANI/PATP/ Au(a), PANI/PATP/Au(b) and CdS/Au(c)

400~1 000 cm⁻¹范围内的谱峰为未被完全覆盖的 PAN I 产生的谱

2 2 PANI 对纳米 CdS 光致发光 (PL) 的增强效应

从CdS-PAN I/PATP/Au 复合膜 PAN I/PATP/Au 和CdS/Au 的光致发光光谱(图 6)可以发现, 负载在Au 上的CdS 微粒膜和 PAN I 膜 PL 非常微弱,而CdS-PAN I/PATP/Au 复合膜在 400 nm 和 530 nm 附近有 2 个发光谱带 400 nm 附近的谱带由导带光生电子和价带光生空穴的带缘复合产生, 530 nm 处的谱带是CdS 微粒通过表面缺陷引起的发光 可见,CdS 纳米微粒负载在Au 上,Au 起到了 荧光猝灭作用,而CdS 纳米微粒分散在 PAN I 膜上, PAN I 使其发光增强

已经发现有两种产生发光增强效应的机理:一种是能量传递机理,例如溴乙锭嵌入DNA 双链中 后,DNA 将吸收的能量传递给溴乙锭,使溴乙锭荧光大为增强;另一种是增加发光的电子和空穴数量 或减少其损耗的机理,如"芯-壳"结构的半导体纳米微粒,宽禁带的半导体"壳",使窄禁带"芯"的电子 和空穴波限制在"芯"内,减少它的无辐射的表面态复合等的损耗,以增强"芯"的光发射^[15].在研究纳 米 ZnO /PAN I 复合膜和同轴纳米线时,发现 PAN I 对 ZnO 的 PL 也有增强效应,并提出载流子传递机 理引起 ZnO 发光增强,即由 PAN I 的光生载流子部分传递给 ZnO,使 ZnO 发光增强^[16-18].

图 7 为CdS-PAN I 复合膜电极暗态下和白光照射下在 0.05 mol/L K₃Fe(CN)₆/K₄Fe(CN)₆ 溶液中 的电流-电位特性曲线,观察到复合膜在暗态下只有阴极电流,说明CdS 为 n 型半导体 光照下,复合 膜电极电位负于- 1.0 V 时产生阴极光电流,电位正于- 1.0 V 时产生阳极光电流,可见光电流-电位 曲线的启动(on set)电位为- 1.0 V,纳米半导体电极的这一电位等效于块体半导体电极的平带电 位^[19].根据上面吸收光谱得到的CdS 禁带能,结合部分氧化态 PAN I 的能带图^[20,21],提出了CdS-PAN I 复合膜的能带图(图 8).由能带图可解释 PAN I 对CdS PL 的增强效应 CdS 的导带缘低于 PAN I 的导带缘,而CdS 的价带缘高于 PAN I 的价带缘,这种能级匹配,使得 PAN I 的光生电子能够有 效地传递给CdS 的导带,光生空穴能有效地传递给CdS 的价带^[20,21],增加了CdS 的载流子数量,从而 导致CdS 的 PL 增强



Fig. 7 *I-V* characteristics of CdS/PANI/PATP/Au electrode in dark and under illumination with white light in 0.05 mol/L K₃Fe(CN)₆/K₄Fe(CN)₆ aqueous solution



Fig. 8 Energy band diagram of CdS/PAN1/PATP/Au composite film in 0.05 mol/L K₃Fe (CN)₆/ K₄Fe(CN)₆ sulotion

3 结 论

利用恒电流脉冲还原法可以 PAN I 膜为基底制备纳米 CdS /PAN I 复合膜,同时 CdS 微粒和 PAN I 之间存在相互作用 纳米 CdS /PAN I 复合膜的紫外-可见吸收谱带主吸收边波长相对块体 CdS 有蓝移, 表现为小颗粒而不是聚集体的性质 由于 PAN I 和 CdS 的能级匹配合理,使得 PAN I 对 CdS 的光致发 光有增强效应,增强机理为载流子传递机理

参考文献

- [1] Wang L. X., Wang F. S. Chin J. Appl Chem. [J], 1990, 7(5): 1-10
- [2] Genies E. M., Boyle A., Lapkow ski M. et al. Synthetic M etals [J], 1990, 36: 139-182

- [3] Wang B. H., Wang D. J., Cui Y. et al. Synth Met [J]., 1995, 71: 2239-2240
- [4] Pethkar S, Patil R. C, Kher J. A. et al. Thin Solid Films [J], 1999, 349: 105-109
- [5] Sun L. D., Fu X. F., Wang M. W. et al. J. Lum in [J], 2000, 87-89: 538-541
- [6] Balakrishnan K. S., Rostogi A. C.. Thin Solid Films[J], 1988, 163: 279-284
- [7] X E Teng-Feng(谢腾峰), WANGDe-Jun(王德军), WANG Ying(王 瑛) *et al*. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报)[J], 1999, **20**(6): 937—940
- [8] Baranski A. S., Fawcett W. R., MacDonald A. C. et al. Electrochem. Soc[J], 1981, 128: 963-968
- [9] Horstweller Angew Chem. Int Ed Engl [J], 1993, 32: 41-53
- [10] Brus L. E. J. Phys Chem. [J], 1990, 90: 2555-2560
- [11] Weller H., Schmidt H. M., Koch U. et al. Chem. Phys Lett [J], 1986, 124(6): 557-559
- [12] Kang E T., Neoh K. G., Tan K. L. Progr. Polym. Sci [J], 1998, 23(1): 57-79
- [13] Dm itri Routkevitch et al. J. Phys Chem. [J] 1996, 100: 14037-14047
- [14] Scott J. F., Leite R. C. C., Damen T. C. Phys Rev. [J], 1969, 188: 1285-1290
- [15] Schlamp M. C., Peng X. G., Alicisatos P. J. Appl Phys [J], 1997, 82(11): 5837-5842
- [16] Zheng Z X, Xi Y. Y., Huang H. G et al. Phys Chem. Commun [J], 2001, 21: 1-2
- [17] Zheng Z X, Xi Y. Y., Dong P. et al. Phys Chem. Commun [J], 2002, 5(9): 63-65
- [18] ZHENG Zhi-Xin(郑志新), XIYan-Yan(席燕燕), HUANG Huai-Guo(黄怀国) et al. Electrochem istry(电化学)[J], 2002, 8(2): 154—159
- [19] Anders Hagfeldt, M ichael Gratzel Chem. Rev. [J], 1995, 95: 49-68
- [20] HUANG Huai-Guo (黄怀国), LUO Jin (罗 瑾), ZHANG Hong-Ping (张红平) et al. Chem. J. Chinese Universities (高等学校化 学学报) [J], 2002, 23(3): 432-436
- [21] Huang H. G., Zheng Z. X., Luo J. et al. Synt Met [J], 2001, 123(2): 321-325

Enhanced Photo-lum inescence Effect of Nano-CdS in the Nano-CdS/PANIComposite Films by PANI

XIYan-Yan¹, ZHOU Jian-Zhang¹, ZHANG Yan¹, DONG Ping¹,

CA I Cheng Dong¹, HUAN G Huai Guo^{2, 3}, L N Zhong Hua¹

(1. State Key Laboratory for Physical Chenistry of the Solid Surface, Department of Chenistry,

Institute of Physical Chemistry, X iam en University, X iam en 361005, China;

2 X iam en Zijin Science and Technology Co., LTD. X iam en 361000, China;

3 Fujian Zijin Research Institute of M ining and M etallurgy,

Fujian Zijin M ining Industry Co., LTD., Longyan 364200, China)

Abstract CdS/PAN I(poly-aniline) composite film was prepared by the current inpulse electrodeposition on the PAN I/PATP (p-am inothiophenol)/Au The structure and performances were characterized by means of SEM and UV-V is, IR, Raman, fluorescence and XPS spectroscopies The CdS nano-particles in the nano-CdS/PAN I composite films show the size quantization effect and the enhanced photolum inescence effect by PAN I The photo-generated carriers transfer mechanism from PAN I into nano-CdS was proposed to explain the effect The chemical interaction between NH-groups of PAN I chains and S²⁻ ions of nano-CdS is found

Keywords Nano-CdS; PAN I; Composite film; Photo-lum inescence

2326

(Ed : S, X)